H_2 在 MgO 团簇吸附的从头计算研究*

陈宏善* 陈华君

(西北师范大学物理与电子工程学院,兰州 730070) (2010年12月22日收到;2011年1月27日收到修改稿)

根据最稳定幻数 MgO 团簇的结构特点,对 H₂ 在岩盐和管状结构(MgO)_{9,12}表面的吸附性质进行了从头计算研究.结果表明 H₂ 可以在处于团簇不同位置的 Mg 正离子或氧负离子上发生物理吸附;在 Mg 离子上 H₂ 以侧位方式吸附并向 Mg 转移电子,在 O 离子上 H₂ 以端位方式吸附并被明显极化.吸附的稳定性主要依赖于吸附离子的位置即配位数,Mg/O 离子的配位数越低则吸附越强;在配位数相同时,H₂ 在 Mg 离子上的吸附强于在 O 离子上的吸附.随吸附位置的不同,吸附能在 0.03—0.08 eV. 计算结果与最近 H₂ 在 MgO 块体表面吸附的实验结果一致.

关键词:团簇, MgO, H₂ 吸附, DFT PACS: 36.40.-c, 31.15.A-, 68.43.Bc

1. 引 言

能源在现代社会发展中具有基础地位,不断增 长的能源需求与化石燃料的有限储量也是当今社 会的主要矛盾之一.氢的储量丰富、燃烧值高、清洁 无污染,是化石燃料的最佳替代品,但气、液、固态 储氢的安全性及化学储氢的经济性阻碍了氢能的 实际应用,因此对各种材料储氢性能的研究具有重 要意义[1-6]. 团簇具有丰富的物理化学性质和极大 的表面/体积比,团簇储氢有可能解决氢的储运问 题.H,在离子型固体表面的吸附很早就引起了人们 的注意,对于H2在晶体氧化镁表面的吸附,曾利用 氦原子散射或中子散射进行了研究[7-9]. 最近实验 表明 H₂ 可以在氧化镁(100)表面发生物理吸附,H, 以平行于表面的方式吸附在 Mg 离子之上,吸附率 在 0.2—0.8 之间时吸附位呈 c(2 × 2) 有序结构, 而 吸附率在 0.8—1.05 之间时呈六边形结构^[9].理论 研究方面, Hermansson 曾利用分子动力学结合从头 计算方法对 H₂ 在 MgO(111) 面上的吸附进行了模 拟^[10]. 最近, Zhang 等人用密度泛函方法对 H₂ 在 MgO(001) 表面的吸附进行了计算^[11], Dawoud 还利 用 Monte Carlo 方法和微扰理论对 D, 在 (001) 面上 的吸附进行了研究^[12]. 对于 H₂ 在 MgO 团簇上的吸 附,仅有 Morokuma 等人利用(MgO)_{n=4,6,8} 模拟氧化 镁晶体的面、棱、角,用从头计算方法研究了 H₂ 在 其上的解离问题^[13,14],而他们的计算并没有考虑 MgO 团簇本身的稳定结构特点. 实验^[15–17] 和理 论^[16–23]研究表明,(MgO)_n 在 n 为 3 的倍数时特别 稳定,而这些幻数团簇的最稳定结构是岩盐结构或 六元管状结构. 本文利用从头计算方法研究了 H₂ 在岩盐结构(MgO)_{9,12}和管状(MgO)₁₂的吸附规律.

2. 计算方法

本文计算是在密度泛函理论 B3LYP^[24]框架下 进行的,即电子交换能采用 HF 和 Becke 三参数混 合形式,电子相关能的定域部分使用函数 VWN Ⅲ^[25],而非定域部分使用 LYP 的泛函形式^[26].计算 使用双ζ基组 6-31G.计算过程首先对(MgO)_n 团簇 的结构进行优化,对各种吸附方式进行非限制完全 优化的基础上,进一步进行频率分析并消去可能存 在的虚频.为了比较,还利用二级微扰理论 MP2/6-311G 对 H₂ 在(MgO)₉上的吸附进行了计算.所有 计算使用 GaussianO3 程序完成^[27].

^{*}国家自然科学基金(批准号:20873102)和西北师范大学科技创新工程(批准号:NWNU-KJCXGC03-62)资助的课题.

[†] E-mail: chenhs@ nwnu. edu. cn

^{©2011} 中国物理学会 Chinese Physical Society

3. 结果讨论

3.1.H, 在岩盐结构(MgO)。表面的吸附

考虑团簇的不同面、边、角,并考虑 H, 吸附在 单个原子之上、不同原子之间以及 H, 的不同取向, 设计了 51 种不同的吸附模式,对各结构进行完全优 化及频率计算,对存在的虚频进行简正模式分析并 消去虚频以得到稳定结构.结果表明,比较稳定的 吸附方式是 H, 吸附在单个 Mg 或 O 离子之上. 在 Mg离子上方,H₂以侧位方式吸附,即分子的方向与 分子到 Mg离子的连线垂直,两个 H 原子处于近似 等价的位置;而在 O 离子上方, H₂ 以端位方式吸附, 即分子的方向与到 0 离子的连线平行. 图 1 中给出 了 H, 在(MgO)。上最稳定的 6 个吸附方式. 表 1 中 列出了 H, 分子的吸附距离、吸附能以及两个 H 原 子上的 Mulligan 电荷. H2 吸附在 Mg 离子上时,给出 的是 Mg 到 H, 分子中心的距离, H, 吸附在 O 离子 上时,给出的是 O 到较近 H 原子的距离;吸附能被 定义为吸附体系的能量与孤立团簇和 H, 分子的能 量之差. H, 分子在 MgO 团簇上的吸附仅为弱的物 理吸附,吸附距离在 2.4—3.6 Å 之间,吸附能主要 与 Mg/O 离子的位置,即它们的配位数相关. 当吸附 在3配位的角上时,吸附能较大,吸附在5配位的面 上时,吸附能最小; Mg, O 离子配位数相同时, H, 在 Mg离子上的吸附比在 O离子上的吸附更强. 电荷 布居数表明,H,吸附在 Mg离子上时,H,分子向 Mg 离子转移电子,H2吸附在O离子上时,H2分子被极 化. 表 1 还给出了在 MP2/6-311G 水平计算得到的 吸附能,表明两种方法给出的结果非常接近.

3.2. H₂ 在岩盐结构(MgO)₁₂表面的吸附

结合(MgO)₁₂的结构特点及 H₂ 在(MgO)₉上的 吸附性质,设计了 H₂ 在(MgO)₁₂上吸附的三十余种 不同方式,对各个结构进行完全优化并消去虚频得 到稳定的吸附结构.图 1 中给出了最稳定的 9 种吸 附方式.同样,吸附能的大小主要依赖于吸附位置, 吸附离子的配位数越小吸附能越大.与(MgO)₉上 的各对应吸附方式比较,H₂ 在(MgO)₁₂上的吸附明 显增强.在(MgO)₁₂上,也存在 H₂ 吸附在 Mg/O 离 子对上方的稳定结构,H₂ 分子的方向大约平行于同 O 离子的连线而垂直于同 Mg 离子的连线,但这种 吸附结构与 H₂ 吸附在 Mg 或 O 离子正上方(亦是稳定的吸附结构)的稳定性差别很小.

我们还优化了多个 H, 分子在(MgO), 上的吸 附结构,吸附方式的选择考虑了角、边、面上的不同 离子并把H,分子限制在团簇的同一侧.图1中给出 了3个这样的吸附结构,优化表明当多个H,分子同 时吸附在团簇表面时,吸附结构与单个分子吸附时 变化很小. 当两个 H_2 吸附在 Mg_{3e} 和 O_{4e} 时, 吸附能 0.113 eV 略小于两个 H, 分子分别吸附在对应位置 的吸附能之和(0.085 + 0.039 = 0.124). 当两个 H₂ 同时吸附在 O3e和 Mg5e时,吸附能 0.084 eV 比两个 H₂分子单独吸附在对应位置的吸附能(0.069 + 0.034 = 0.103)小20%. 而当三个 H, 分子吸附在同 一面上的 Mg_{3c}, O_{4c}和 O_{5c}/Mg_{5c}时, 吸附能 0.119 eV 比三个 H, 分别吸附的能量之和(0.154 eV)小 23%. 这表明由于 H₂ 在 MgO 团簇表面仅存在较弱 的物理吸附,多个 H,分子可以同时形成稳定的吸 附,吸附的强度较单个分子吸附时有所减弱,但减 弱的程度不大.

3.3. H₂ 在管状(MgO)₁₂表面的吸附

考虑管状(MgO)₁₂的对称性及结构特点,设计 了 H₂ 分子在管外各个不等价位置的吸附方式并进 行结构优化和频率分析,图 1 给出了最稳定的 4 种 吸附方式.与在岩盐结构上的吸附类似,H₂ 分子以 侧位方式吸附在 Mg 离子上方或以端位方式吸附在 O 离子上方,且吸附能与在岩盐结构上具有相同的 配位数的 Mg/O 离子上的吸附能接近.

对于 H₂ 在 MgO 表面的吸附,只有 Hermansson 等人的计算给出了解离吸附^[10].他们利用分子动力 学对 MgO 层状模型进行模拟退火,结合 Hartree-Fock CO-LCAO 计算得到 H₂ 在(111)面上形成化学 吸附,吸附能为 0.6 eV. Zhang 等人用密度泛函方 法对 H₂ 在 MgO(001)表面的吸附进行了研究^[11], 表明解离吸附的能垒为 2.2 eV,因此只能发生物理 吸附,而在 Mg,O 离子及桥位上形成物理吸附的能 量分别为 0.054,0.015 和 0.053 eV. Dawoud 利用 Monte Carlo 方法结合微扰理论对 D₂ 在 (001)面上 的研究也表明仅发生物理吸附^[12],随吸附量的增 加,D₂ 在 (001)面上形成 $p(2 \times 2), p(4 \times 2)$ 等结 构,而在 Mg,O 离子上的吸附能为 0.016 和 0.012 eV. 对于 H₂ 在 (MgO)_{n=4,6,8}上的吸附,Morokuma 利 用从头计算研究表明解离过程的能垒在 2.3 eV 以 上^[13,14], 对 H₂ 的物理吸附, 他们仅给出了在 $(MgO)_4$ 上的结果, 不同精度的计算表明 H₂ 在 Mg,

O离子上的吸附能约为 0.08 eV,在 Mg离子上的吸附略强于在 O离子上的吸附.



图 1 H₂ 在岩盐结构(MgO),及岩盐和管状(MgO)₁₂团簇上的吸附结构

3.4. H₂ 吸附在(MgO), 团簇上的分子轨道特征

对单个 Mg, O 原子, 原子轨道的能级顺序为 Mg

的 2s,2p,O 的 2s,2p,Mg 的 3s,H₂ 分子的轨道能介 于 O 的 2p 和 Mg 的 3s 之间. Mg,O 原子形成 (MgO)_n 团簇后,Mg 的 3s 电子向 O 的 2p 空轨道转

·汉阳阳以及虽然1 王印 mulligan 七同			
	距离/Å	吸附能/eV	氢原子电荷/e
岩盐结构 (MgO),			
$H_2 - Mg_{3c}$	2.44	0.071 (0.075)	0.03 / 0.02
$H_2 - O_{3c}$	2.69	0.057 (0.056)	-0.11 / 0.11
$H_2 - Mg_{4c}$	2.69	0.035 (0.037)	0.01 / 0.02
$H_2 - O_{4c}$	3.06	0.030 (0.038)	-0.03 / 0.04
$H_2 - Mg_{5c}$	3.58	0.028 (0.031)	0.01 / 0.01
$H_2 - O_{5c}$	3.24	0.024 (0.023)	0.00 / 0.01
岩盐结构 (MgO) ₁₂			
$H_2 - Mg_{3c}$	2.44	0.085	0.03 / 0.02
$H_2 - O_{3c}$	2.70	0.069	-0.11 / 0.11
$\rm H_2-Mg_{4c}/O_{3c}$	2.77/3.02	0.046	-0.03 / 0.05
$\rm H_2-O_{4c}/Mg_{3c}$	2.72/3.08	0.039	-0.03 / 0.04
$H_2 - Mg_{4c}$	2.68	0.048	0.02 / 0.02
$H_2 - O_{4c}$	3.08	0.045	-0.03 / 0.04
$H_2 - Mg_{5c}$	3.53	0.034	0.01 / 0.01
$H_2 - O_{5c}$	3.33	0.030	-0.01 / 0.02
$\rm H_2-Mg_{5c}/O_{5c}$	3.50/3.50	0.033	0.00 / 0.02
$H_2 - Mg_{3c}$	2.44	0. 113	0.02 / 0.04
$+ \mathrm{H_2} - \mathrm{O}_{\mathrm{4c}}$	3.10		-0.03 / 0.04
$H_2 - O_{3c}$	2.70	0.084	-0.11 / 0.10
$+ H_2 - Mg_{5c}$	3.53		0.01 / 0.01
$H_2 - Mg_{3c}$	2.44		0.02 / 0.04
$+\mathrm{H}_2-\mathrm{O}_{4\mathrm{c}}$	3.10	0. 119	-0.03 / 0.04
+ $\rm H_2$ – $\rm O_{5c}/Mg_{4c}$	3.51/4.11		0.00 / 0.01
管状结构 (MgO) ₁₂			
$H_2 - Mg_{3c}$	2.46	0.079	0.02 / 0.02
$H_2 - O_{3c}$	2.76	0.061	-0.09 / 0.09
$H_2 - Mg_{4c}$	2.76	0.048	-0.01 / 0.04
$H_2 - O_{4c}$	3.21	0.032	-0.01 / 0.02

表1 H₂分子在 MgO 团簇表面的吸附距离 吸附能以及氢原子上的 Mulligan 电荷

注:对于 H₂ 在(MgO), 上的吸附, 括号中的吸附能为 MP2/6-311G 水平的计算值.

移,0的轨道能级被抬高,它们形成的能带位于约-14—-10 eV 之间,而最低空轨道具有很小的正的 轨道能,因此(MgO)。团簇的能带具有典型的绝缘 体特征.当H,分子吸附在 MgO 团簇上时,其轨道能 降低到约-16 eV,位于 O 的 2p 和 Mg 的 3s 形成的 能带之下;由于团簇的价带是满的,它们不能与H₂ 有效的形成分子轨道,因此吸附为弱的物理吸附. 图 2 给出了 H₂ 分子吸附在(MgO), 上时有 H 参与 形成的典型轨道. 我们看到由 H2 为主形成的轨道 保持了自由 H₂ 分子的轨道特征,同时 H 的轨道也 以很小的分量参与了一些团簇的轨道.当H,吸附 在 Mg 离子上时,由于 Mg 参与形成分子轨道的 3s 是空的(即形成正离子),H,分子以侧位方位吸附 在离子上方并向 Mg 离子转移电子;当 H, 吸附在 O 离子上时,由于 O 的 2p 轨道是占满的并在 H, 的附 近形成了较大的电荷分布,H,分子以端位方式吸附 在 0 离子上方并被极化.

3.5. 吸附 H₂ 的脱附能量曲线

最后我们考察了吸附在岩盐结构(MgO)₁₂上的 H₂ 分子的脱附过程. 通过控制 H₂ 分子到吸附 位(Mg/O 离子)的距离进行部分结构优化得出脱 附过程的能量变化. 图 3 给出了吸附在 Mg_{3e}及 O_{4e}/Mg_{3e}的 H₂ 在脱附过程的势能曲线. 正如一般的物理吸附所具有的普遍特征,随着 H₂ 分子吸 附距离的增大,体系的能量单调升高,并不存在能垒.



图 2 H₂ 分子吸附在(MgO),上时有 H 参与形成的典型轨道



图 3 H₂ 在 (MgO)₁₂团簇表面的脱附过程

4.结 论

设计了 H₂ 在岩盐结构(MgO),及岩盐和管状

- [1] Schlapbach L, Züttel A 2001 Nature 414 353
- [2] Coontz R, Hanson B 2004 Science 305 957
- [3] Zhao Y F, Kim Y H, Dillon A C, Heben M J, Zhang S B 2005 Phys. Rev. Lett. 94 155504
- [4] Zhou J J, Chen Y G, Wu Z L, Zheng X, Fang Y C, Gao T 2009 Acta Phys. Sin. 58 4853 (in Chinese) [周晶晶、陈云贵、吴朝 玲、郑 欣、房玉超、高 涛 2009 物理学报 58 4853]
- [5] Ni M Y, Wang X L, Zeng Z 2009 Chin. Phys. B 18 357
- [6] Liu X Y, Wang C Y, Tang Y J, Sun W G, Wu W D 2010 Chin. Phys. B 19 036103
- [7] Degenhardt D, Lauter H J, Haensel R 1987 Jpn. J. Appl. Phys. 26 341
- [8] Skofronick J G, Toennies J P, Traeger F, Weiss H 2003 Phys. Rev. B 67 035413
- [9] Larese J Z, Arnold T, Frazier L, Hinde R J, Ramirez Cuersta A J 2008 Phys. Rev. Lett. 101 165302
- [10] Hermansson K, Baudin M, Ensing B, Alfredsson M, Wojcik M 1998 J. Chem. Phys. 109 7515
- [11] Wu G X, Zhang J Y, Wu Y Q, Li Q, Chou K C, Bao X H 2009 J. Alloys Compd. 480 788
- [12] Dawoud J N, Jack D B 2009 Appl. Surf. Sci. 256 1443
- [13] Sawabe K, Koga N, Morokuma K, Lwasawa Y 1992 J. Chem.

(MgO)₁₂团簇上的各种可能吸附方式,对吸附性质 进行了第一性原理优化计算.结果表明H₂在MgO 团簇上存在物理吸附,且能够被吸附在不同位置 的Mg正离子和O负离子之上.吸附的稳定性主要 决定于Mg/O离子的位置,即他们的配位数,当H₂ 被吸附在3配位的边角位置时吸附最强,吸附在4 配位的棱上时吸附强度减弱,吸附在5配位的面 上位置时强度最弱;当Mg/O离子所处位置相同 时,H₂在Mg离子上的吸附更加稳定.当H₂被吸 附在Mg离子上时,H₂的方向垂直于到Mg离子的 方向,两个H近似等价并向Mg离子转移电荷,而 在O离子上方H₂以端位方式吸附并被明显极化. H₂在MgO团簇的吸附能介于0.03—0.08 eV,当 在同一团簇吸附多个H₂分子时,吸附强度会有所 减弱.

Phys. 97 6871

- [14] Sawabe K, Koga N, Morokuma K, Lwasawa Y 1994 J. Chem. Phys. 101 4819
- [15] Ziemann P J, Castleman A W Jr. 1991 J. Chem. Phys. 94 718
- [16] Saunders W A, 1989 Z. Phys. D: At. Mol. Clust. 12 601
- [17] Katakuse I, Ichihara T, Ito H, Hirai M 1990 Mass Spectr. 4 16
- [18] Fu X H, Yin Y, Zhang L, Ye H 2009 Acta Phys. Sin. 58 5007 (in Chinese) [傅兴海、尹 伊、张 磊、叶 辉 2009 物理学 报 58 5007]
- [19] Dong R B, Chen X S, Wang X F, Lu W 2008 J. Chem. Phys. 129 044705
- [20] Carrasco J, Illas F, Bromley S T 2007 Phys. Rev. Lett. 99 235502
- [21] Jain A, Kumar V, Sluiter M, Kawazoe Y 2006 Comput. Mater. Sci. 36 171
- [22] Bawa F, Panas I 2002 Phys. Chem. Chem. Phys. 4 103
- [23] Calvo F 2003 Phys. Rev. B 67 131403
- [24] Becke A D 1993 J. Chem. Phys. 98 5648
- [25] Vosko S H, Wilk L, Nusair M 1980 Can. J. Phys. 58 1200
- [26] Lee C, Yang W, Parr R G 1988 Phys. Rev. B 37 785
- [27] Frisch, M J, Trucks G W, Schlegel H B et al Gaussian 03. Revision E. 01. Wallingford CT: Gaussian Inc. 2004.

Adsorption of H₂ on MgO clusters studied by ab initio method^{*}

Chen Hong-Shan[†] Chen Hua-Jun

(College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China) (Received 22 December 2010; revised manuscript received 27 January 2011)

Abstract

Based on the most stable structures of the magic MgO clusters, the adsorption of H_2 onto the rocksalt and hexagonal tube $(MgO)_{9,12}$ is studied using first principal method. The results show that physical adsorption can be formed on Mg^{+q} or O^{-q} ions at different sites of the clusters. On the top of the Mg^{+q} ions, H₂ is adsorbed in the side-on manner and donates electrons to the ions. On the top of the O^{-q} ions, H₂ is adsorbed in the end-on manner and the molecule is polarized. The strength of the adsorption depends mainly on the location of the Mg/O ions, and the smaller the coordination number of the ions, the stronger the adsorption of H₂ is. For the Mg/O ions with the same coordination number, the adsorption formed onto the Mg^{+q} is stronger. According to the Mg or O ions and their locations, the adsorption energy ranges from 0. 03 eV to 0. 08 eV.

Keywords: cluster, MgO, H₂ adsorption, DFT **PACS**: 36.40.- c, 31.15. A - , 68.43. Bc

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 20873102) and the Northwest Normal University (Grant No. NWNU-KJCXGC-03-62).

[†] E-mail: chenhs@ nwnu. edu. cn